

97-0328

Rezumat:

Invenția se referă la structurile multistrat de semiconductori sticloși cu schimbarea bruscă sau lentă a indicelui de refracție la hotarul dintre straturi și poate fi utilizată la confecționarea purtătorilor pentru transmiterea și înregistrarea informației optice.

În scopul simplificării tehnologiei pe suport rigid sau flexibil prin evaporarea termică în vid se depun diferite după compoziție straturi de semiconductori calcogenici sticloși cu diferiți indici de refracție din As_2S_3 , schimbându-i temperatura de evaporare de la 120 până la 280°C.

Revendicări: 1